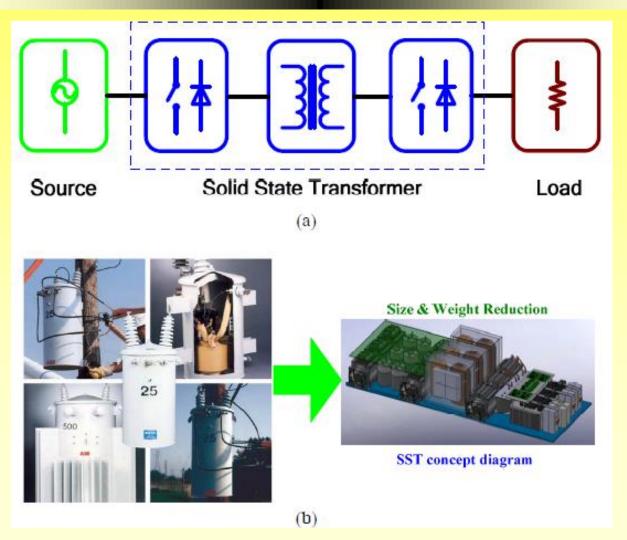
## F.C.E.F. y N. – DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA CÁTEDRA DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

# TRANSFORMADORES DE ESTADO SOLIDO (S.S.T.)

Ing. Adrián Agüero Prof. Titular

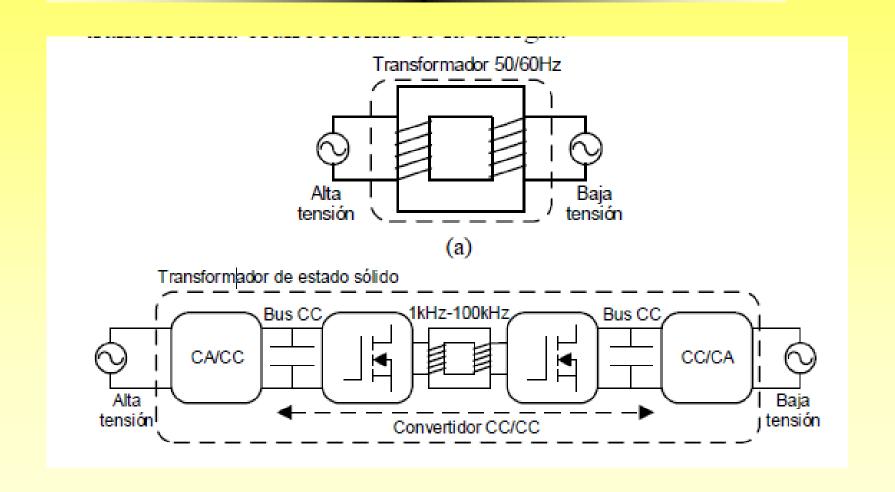


#### **CONCEPTO BÁSICO DE SST**



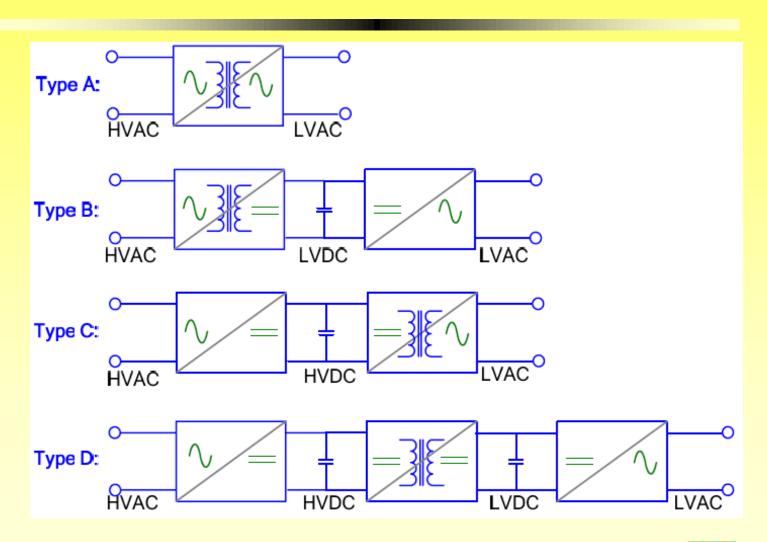


#### **CONCEPTO BÁSICO DE SST**



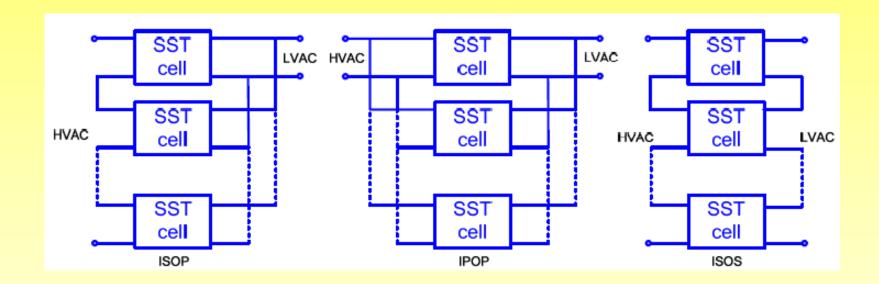


#### CLASIFICACIÓN DE LAS TOPOLOGÍAS DE SST



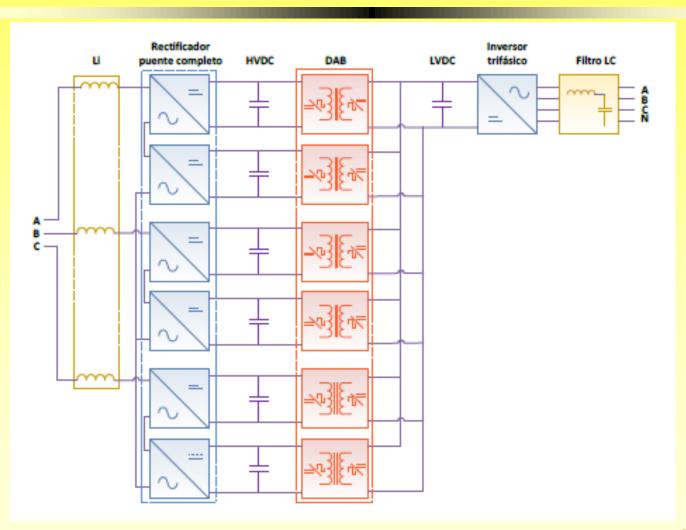


#### SST EN SISTEMA DE HV Y HP



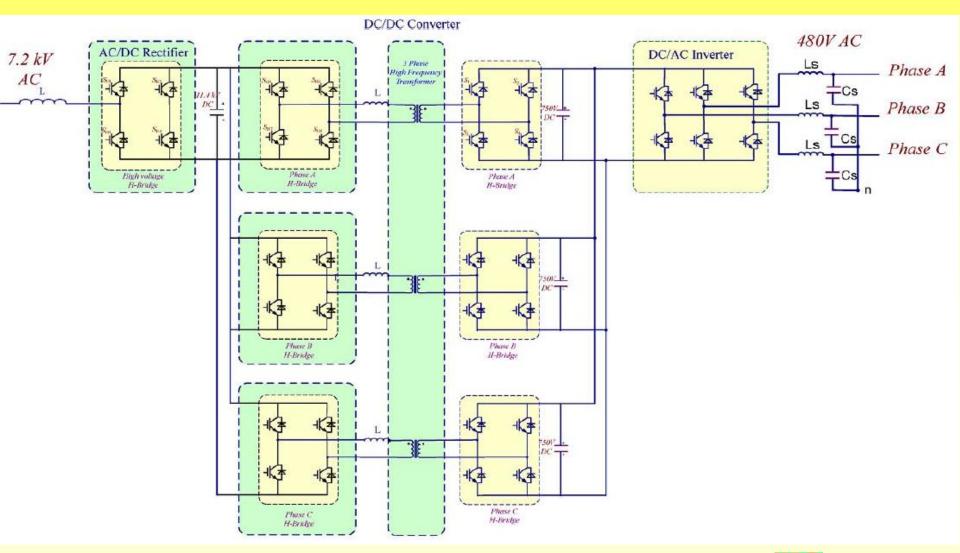


#### SST EN SISTEMA DE HVY HP



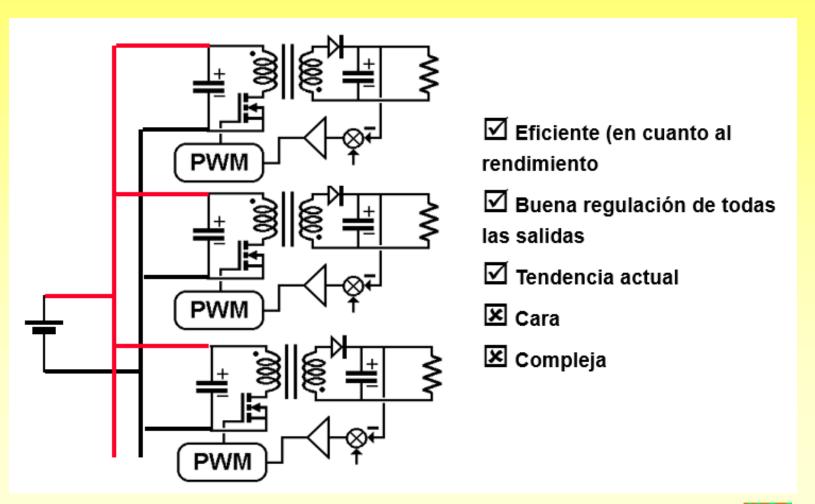


#### TOPOLOGIA DE UN SST TRIFÁSICO

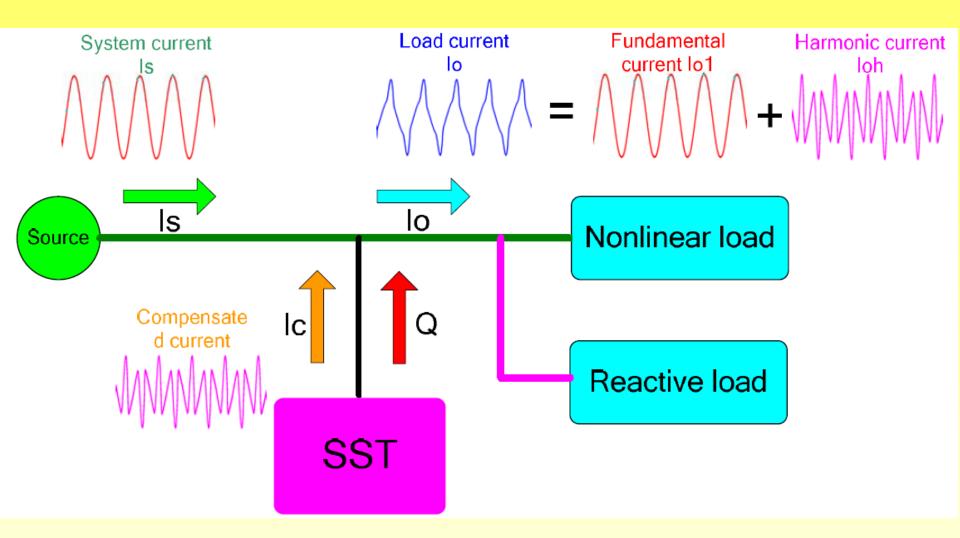




#### **COVERTIDORES DC/DC MULTISALIDA EN PARALELO**

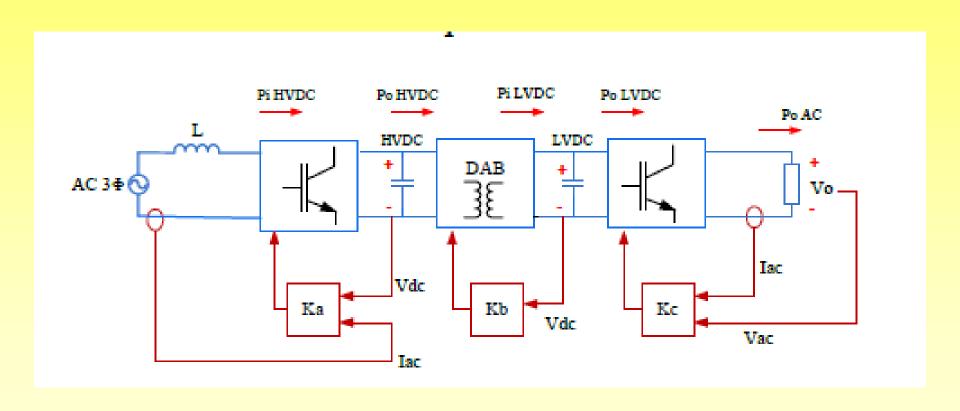


#### TOPOLOGIA DE UN SST TRIFÁSICO



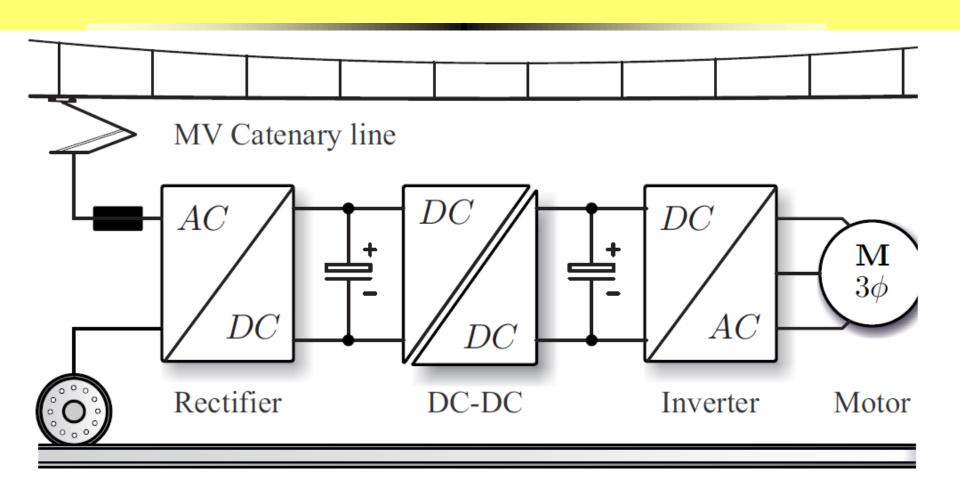


#### **ESQUEMA DE CONTROL DE UN SST**



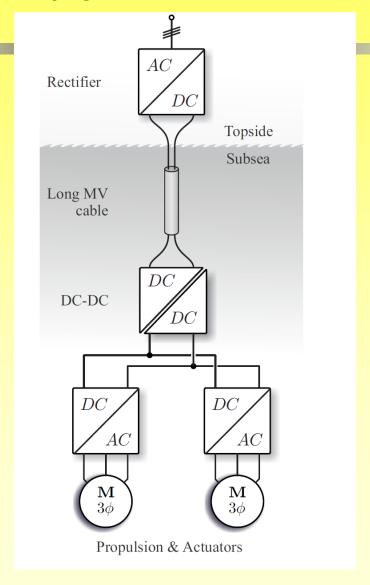


#### **APLICACIONES (Tracción de una locomotora)**



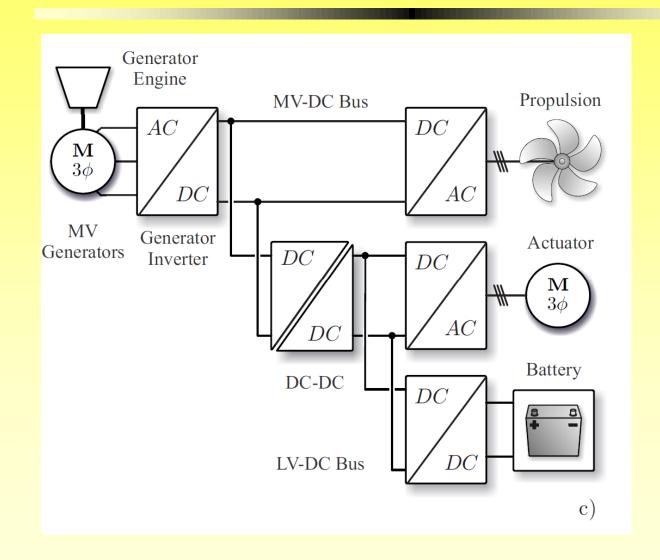


#### APLICACIONES (Operación remota de un vehículo)



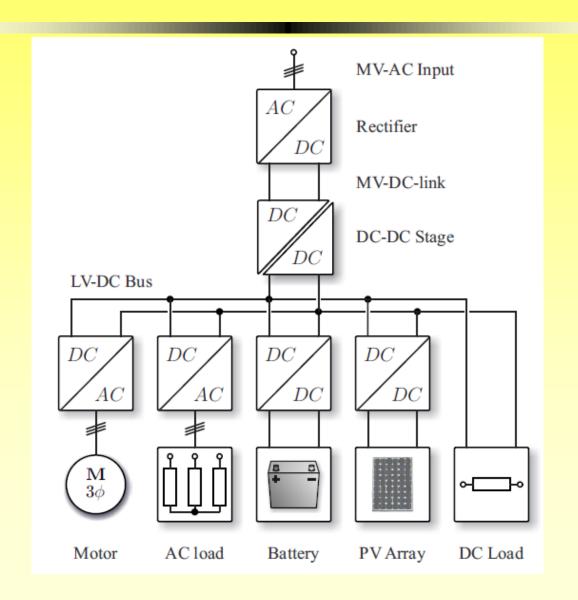


## APLICACIONES (Arquitectura de un barco con distribución DC)





#### APLICACIONES (Microdistribución en DC)





## SEGMENTO DEL MERCADO DE LA TECNOLOGIA TIES

((Transformador Inteligente de Estado Sólido)

### • Convertidores

- Semiconductores de potencia
- Transformadores de Alta Frecuencia (TAF)
- Plataformas de Control y Comunicación (PCC) basadas en sistemas digitales

#### **Aplicaciones**

- Redes Eléctricas Inteligentes (SmartGrid)
- Energías
   Renovables (ER)
- Vehículos Eléctricos
- Trenes Eléctricos
- Otros (Barcos, Submarinos y Aviones)

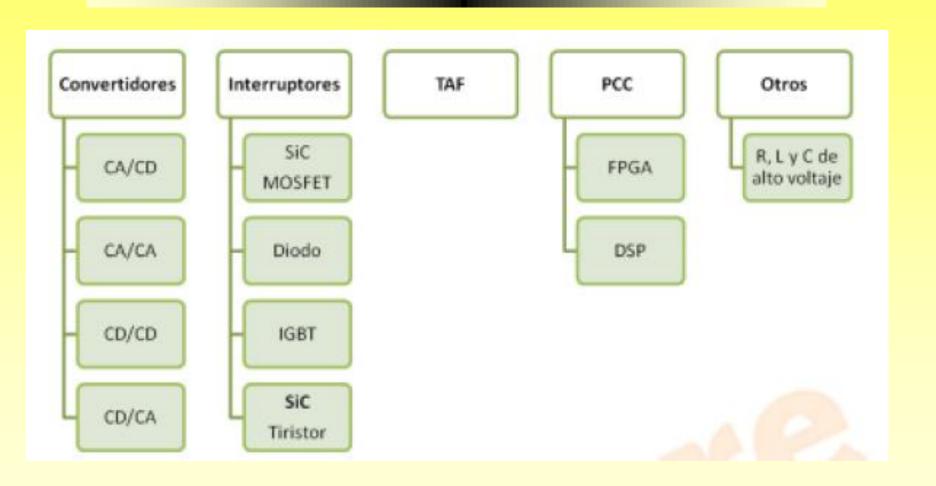
#### Zona Geográfica

- América
- Europa
- · Asía-Pacífico
- Resto del Mundo (REM)

Figura 11. Segmentos del mercado de la tecnología del TIES.

## SEGMENTO DE COMPONENTES DE LA TECNIOLOGÍA TIES

((Transformador Inteligente de Estado Sólido)



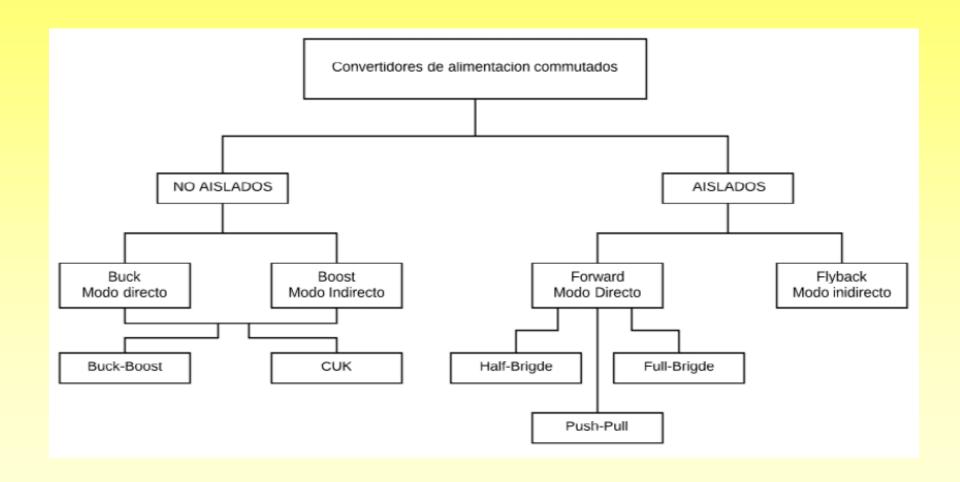


## SEGMENTO DE COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA TIES (Transformador Inteligente de Estado Sólido)

De acuerdo con el reporte de *MarketsandMarkets*, las principales empresas que están desarrollando investigación sobre la tecnología del TIES incluyen a: ABB (Suiza), *Siemens AG* (Alemania), *Schneider Electric SA* (Francia), *Alstom* (Francia), *Avago Technologies Limited* (EE.UU.), *Bombardier Inc* (Canadá), *Cooper Power Systems* (EE.UU.), *Mitsubishi Electric Corporation* (EE.UU.), CREE Inc (EE.UU.), *Infineon Technologies* (Alemania), *STMicroelectronics* (EE.UU.), *SPX Transformers* (EE.UU.), *General Electric* (EE.UU.), *Duke Energy* (EE.UU.), *Plasmatechnics Inc.* (EE.UU.), *Selco* (EE.UU.), *Varentec* (EE.UU.), y *Gridco Systems* (EE.UU.). Se incluyen empresas que cubren desde partes y suministros para equipos, hasta empresas integradoras de la tecnología relacionada.



#### CLASIFICACIÓN DE LOS CONVERTIDOS





#### **MODOS DE CONDUCCIÓN**

#### 3.2.1.- Modos de conducción

Todos los convertidores pueden presentar dos modos de conducción, los cuales se deben a la relación entre el tiempo en el que el conmutador se encuentra cerrado, y el tiempo necesario para que la bobina descargue totalmente la energía almacenada previamente [11]. Los modos de conducción posibles son:

- Modo de conducción continua (MCC): La intensidad que fluye por la carga fluctúa entre unos valores máximo y mínimo, pero nunca llega a anularse. Esto se debe a que el conmutador deberá estar bloqueado un intervalo de tiempo que permita a la intensidad en la carga no hacerse cero. De este modo, al comenzar el siguiente periodo la intensidad podrá partir de un valor inicial, I<sub>L(MIN)</sub>.
- Modo de conducción discontinua (MCD): La intensidad en la carga se hace nula
  en un momento determinado a lo largo de un intervalo de tiempo Toff durante
  el cual el interruptor esta abierto. El tiempo que permanece abierto el
  interruptor es mayor que el tiempo que puede estar la bobina cediendo energía,
  con lo que al iniciarse el siguiente periodo la intensidad en la carga partirá de
  cero.



#### **MODOS DE CONDUCCIÓN**

Ambos modos de operación quedan reflejados en la figura 1, para el caso de un chopper reductor.

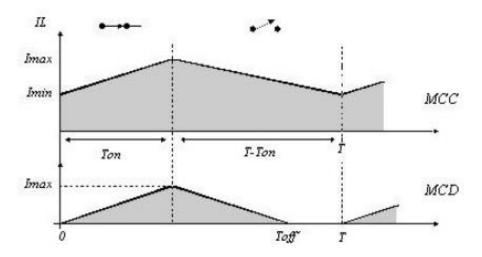


Fig. 1. Intensidad en la bobina para un chopper reductor para modos de conducción MCC y MCD.



#### **DISPOSITIVOS DE POTENCIA**

			David Ramón Marco
Tipo de	BJT	MOSFET	IGBT
transistor			
Voltaje	1000 – 1200 V	500 – 1000 V	1600 – 2000 V
Intensidad	700 – 1000 A	20 – 100 A	400 – 500 A
Frecuencia	25kHz	Hasta 300 – 400kHz	Hasta 75kHz
Potencia	P medias	P bajas (<10kW	P medias - altas

Tabla 13. Comparativa entre los diferentes tipos de transistores.



#### **PREGUNTAS**

